

SOT223 P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

ZVP2110G

ISSUE 2 – MARCH 94

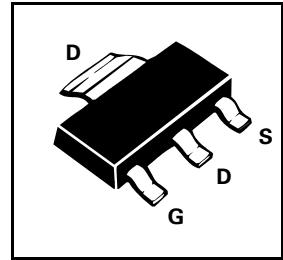


FEATURES

- * 100 Volt V_{DS}
- * $R_{DS(on)}=8\Omega$

COMPLEMENTARY TYPE – ZVN2110G

PARTMARKING DETAIL – ZVP2110



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

| PARAMETER | SYMBOL | VALUE | UNIT |
|---|----------------|-------------|-------------|
| Drain-Source Voltage | V_{DS} | -100 | V |
| Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}C$ | I_D | -310 | mA |
| Pulsed Drain Current | I_{DM} | -3 | A |
| Gate Source Voltage | V_{GS} | ± 20 | V |
| Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$ | P_{tot} | 2 | W |
| Operating and Storage Temperature Range | $T_j; T_{stg}$ | -55 to +150 | $^{\circ}C$ |

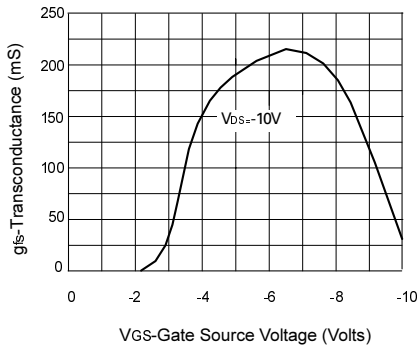
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | MAX. | UNIT | CONDITIONS. |
|---|--------------|------|------------|--------------------|---|
| Drain-Source Breakdown Voltage | BV_{DSS} | -100 | | V | $I_D=-1mA, V_{GS}=0V$ |
| Gate-Source Threshold Voltage | $V_{GS(th)}$ | -1.5 | -3.5 | V | $I_D=-1mA, V_{DS}=V_{GS}$ |
| Gate-Body Leakage | I_{GSS} | | 20 | nA | $V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0V$ |
| Zero Gate Voltage Drain Current | I_{DSS} | | -1 -100 | μA μA | $V_{DS}=-100V, V_{GS}=0$ $V_{DS}=-80V, V_{GS}=0V, T=125^{\circ}C(2)$ |
| On-State Drain Current(1) | $I_{D(on)}$ | -750 | | mA | $V_{DS}=-25V, V_{GS}=-10V$ |
| Static Drain-Source On-State Resistance (1) | $R_{DS(on)}$ | | 8 | Ω | $V_{GS}=-10V, I_D=-375mA$ |
| Forward Transconductance (1)(2) | g_{fs} | 125 | | mS | $V_{DS}=-25V, I_D=-375mA$ |
| Input Capacitance (2) | C_{iss} | | 100 | pF | $V_{DS}=-25V, V_{GS}=0V, f=1MHz$ |
| Common Source Output Capacitance (2) | C_{oss} | | 35 | pF | |
| Reverse Transfer Capacitance (2) | C_{rss} | | 10 | pF | |
| Turn-On Delay Time (2)(3) | $t_{d(on)}$ | | 7 | ns | $V_{DD}=-25V, I_D=-375mA$ |
| Rise Time (2)(3) | t_r | | 15 | ns | |
| Turn-Off Delay Time (2)(3) | $t_{d(off)}$ | | 12 | ns | |
| Fall Time (2)(3) | t_f | | 15 | ns | |

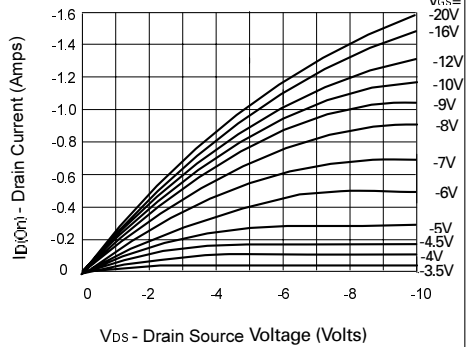
(1) Measured under pulsed conditions. Width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$ (2) Sample test.

ZVP2110G

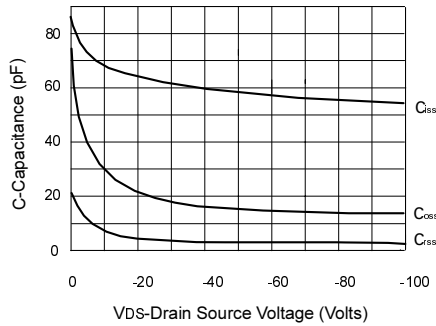
TYPICAL CHARACTERISTICS



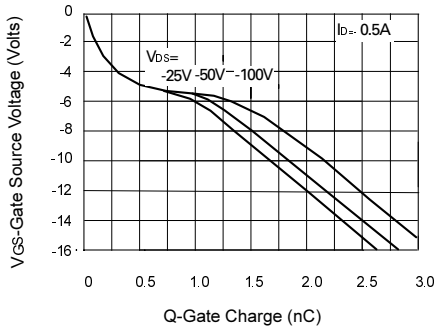
Transconductance v gate-source voltage



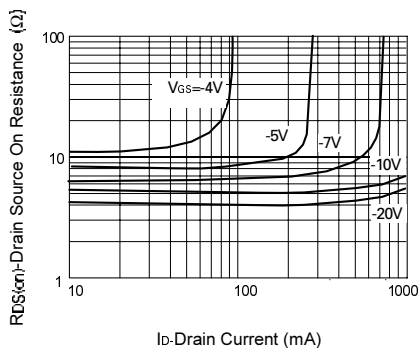
Saturation Characteristics



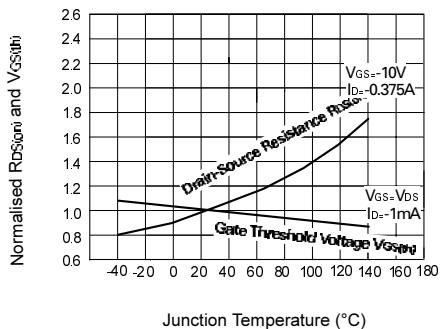
Capacitance v drain-source voltage



Gate charge v gate-source voltage



On-resistance v drain current



Normalised RDS(on) and VGS(th) vs Temperature

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru